		<u> </u>	-	•	<u> </u>
	AБВГ.123.008 ПЭЗ	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
Перв.примен.			Кварцевый генератор		
		BQ1	РК374 АДКШ.433510.013 ТУ	1	
Герв.п					
			Конденсаторы		
		C1C23	Epcos B45196P6104K109 - 35 B - 0,1 мкФ ± 10%	23	
Ц		C24	Epcos B45196P4684K109 - 20 B - 0,68 мкФ ± 10%	1	
		C25C31	Epcos B45196P6104K109 - 35 B - 0,1 мкФ ± 10%	7	
		C32	Ерсоs B45196P2107K109 - 10 B - 100 мкФ ± 10%	1	
		C33C39	Epcos B45196P6104K109 - 35 B - 0,1 мкФ ± 10%	7	
Справ. И		C40C43	Epcos B45196P2107K109 - 10 B - 100 мкФ ± 10%	4	
Ω		C44	Epcos B45196P6104K109 - 35 B - 0,1 мκΦ ± 10%	1	
			Микросхемы		
Ш		D1D8	HCPL-063A	8	
		D9	ADM233LAN	1	
		D10D13	HCPL-063A	4	
П		D14	DS87C550-FNL	1	
ama		D15	XC3042-70PQ100I	1	
Подп.и даг		D16, D17	HCPL-063A	2	
Πō		D18	MAX810EUR-T	1	
Н		D19	XC1736DDD8	1	
Эубл.		D20	К1564ЛИ1	1	
Инв. N дубл.		D21	HCPL-063A	1	
Z		D22	К1554ИР35	1	
18.N		D23	AM29F010	1	
Взам.инв.N		D24	ADM233LAN	1	
B3		<i>D21</i>	715 M LOOL III		
			Г		
Подп.и дата					
одп.и					
L		Mark Throne	<i>ΑδΒΓ.12</i>	3.008	3 ПЭ3
Н		Изм Лист Разраб.	N докум. Подп. Дата Нернышев В.	ſ	Пит. Лист Листов
подп		Пров. д Нач.Отд.	_{Дудкевич} Блок защиты информации	F	1 4
Инв.N подл.		Н.контр.	Перечень элементов		
Ĺ		Утв.	Vолипосол.		Формат ЛЛ

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание	
	Микросхемы			
D25, D26	HCPL-063A	2		
D27	MAX4576ESA	1		
D28	LM2586S-5.0	1		
D29	К1564ЛЕ1	1		
D30	MAX968ESA	1		
	Резисторы			
	Р1-12 ОЖО.467.169ТУ			
R1R15	P1-12-0,032 - 750 Ом ± 10%	15		
R16R25	P1-12-0,032 - 360 Ом ± 10%	10		
R26R33	P1-12-0,032 - 750 Ом ± 10%	8		
R34R41	P1-12-0,032 - 360 Ом ± 10%	8		
R42R45	P1-12-0,032 - 301 Ом ± 10%	4		
R46R49	P1-12-0,032 - 750 Ом ± 10%	4		
R50, R51	P1-12-0,032 - 5,1 кОм ± 10%	2		
R52R55	P1-12-0,032 - 301 Ом ± 10%	4		
R56R61	P1-12-0,032 - 360 Ом ± 10%	6		
R62R65	P1-12-0,032 - 301 Ом ± 10%	4		
R66R69	P1-12-0,032 - 750 Ом ± 10%	4		
R70	P1-12-0,032 - 1 кОм ± 10%	1		
R71	P1-12-0,032 - 2 кОм ± 10%	1		
R72	P1-12-0,032 - 1 кОм ± 10%	1		
R73R76	P1-12-0,032 - 360 Ом ± 10%	4		
R77R80	P1-12-0,032 - 301 Ом ± 10%	4		
R81, R82	P1-12-0,032 - 10 кОм ± 10%	2		
R83	P1-12-0,032 - 68 кОм ± 10%	1		
R84	P1-12-0,032 - 10 кОм ± 10%	1		
R85	P1-12-0,032 - 19,7 кОм ± 10%	1		
R86R88	P1-12-0,032 - 100 кОм ± 10%	3		
		•		
	4555 400	Лист		
Изм. Лист	N докум. Подп. Дата АБВГ.123.	UU8	1133	

Подп.и дата

Инв. N дубл.

Взам.инв.N

Подп.и дата

Инв.N подл.

	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание			
Ì		Диоды					
	VD1	General Semiconductor SS24	1				
		Вилки					
	XS1	KARSON Technology DBR-9 420-092-20	1				
	XS2	KARSON Technology DBR-9 420-252-20	1				
	XS3	KARSON Technology DBR-9 420-092-20	1				
	XT1	BH20-2M	1				
		Трансформатор					
	ZL1	Renco Electronics RL-5751	1				
Ī							
ı							
İ							
ŀ							
_							
ŀ							
ŀ							
_							
ŀ							
-							
1			-				
-							
-							
-							
ᆛ							
	, ,						
-	АБВГ.123.008 ПЭЗ						
	Изм Лист						

Подп.и дата

Инв. N дубл.

Взам.инв.N

Подп.и дата

Инв.N подл.

	Лист регистрации изменений											
	Из	м.	Изме- нен- ных	Номера . Заме- нен- ных	листов (і - Нов		ц) Анну- лиро- ван- ных	Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводи- тельного документа	Подп.	Дата
Подп.и дата												
Инв. N дубл.												
Взам.инв.N												
Подп.и дата												
Инв.N подл.	Изі	1 Лис	ист N докум. Подп. Дата				АБВГ.123.008 ПЭ3				Лист	